

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関  
国際事務局

(43) 国際公開日  
2025年5月1日(01.05.2025)



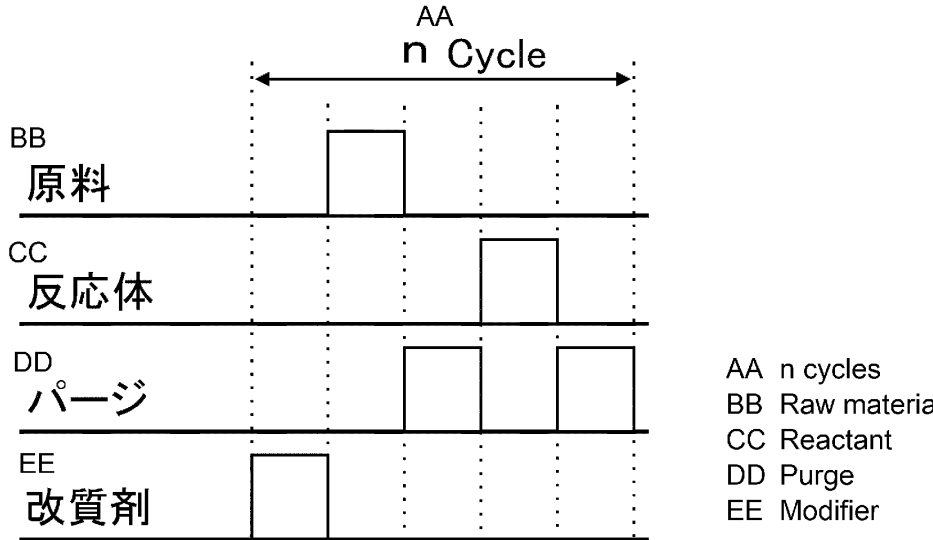
(10) 国際公開番号

WO 2025/088973 A1

- (51) 国際特許分類:  
H01L 21/318 (2006.01) H01L 21/31 (2006.01)  
C23C 16/455 (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2024/034283
- (22) 国際出願日: 2024年9月25日(25.09.2024)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:  
特願 2023-184760 2023年10月27日(27.10.2023) JP
- (71) 出願人: 株式会社 KOKUSAI ELECTRIC (KOKUSAI ELECTRIC CORPORATION)  
[JP/JP]; 〒1010045 東京都千代田区神田鍛冶町三丁目4番地 (JP).
- (72) 発明者: 野原 慎吾(NOHARA Shingo); 〒9392393 富山県富山市八尾町保内二丁目1番地 株式会社 KOKUSAI ELECTRIC 内 (JP). 石橋 清久(ISHIBASHI Kiyohisa); 〒9392393 富山県富山市八尾町保内二丁目1番地 株式会社 KOKUSAI ELECTRIC 内 (JP). 山根 耀真(YAMANE Yoma); 〒9392393 富山県富山市八尾町保内二丁目1番地 株式会社 KOKUSAI ELECTRIC 内 (JP). 新村 純平(SHIMURA Jumpei); 〒9392393 富山県富山市八尾町保内二丁目1番地 株式会社 KOKUSAI ELECTRIC 内 (JP).
- (74) 代理人: 福岡 昌浩, 外(FUKUOKA Masahiro et al.); 〒1020072 東京都千代田区飯田橋四丁目6番1号 21東和ビル3階 (JP).

(54) Title: SUBSTRATE PROCESSING METHOD, METHOD FOR PRODUCING SEMICONDUCTOR DEVICE, PROGRAM, AND SUBSTRATE PROCESSING DEVICE

(54) 発明の名称: 基板処理方法、半導体装置の製造方法、プログラムおよび基板処理装置



(57) Abstract: A method according to the present invention includes: (a) a step for setting the supply amount of a modifier on the basis of a relationship between the supply amount of the modifier and the characteristic of saturated adsorption of a raw material to a substrate; and (b) a step for supplying the modifier to the substrate on the basis of the set supply amount.

[続葉有]

(81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CV, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IQ, IR, IS, IT, JM, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, MG, MK, MN, MU, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, CV, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SC, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

一 国際調査報告(条約第21条(3))

---

(57) 要約: (a) 改質剤の供給量と基板に対する原料の飽和吸着特性との関係に基づいて、前記改質剤の供給量を設定する工程と、(b) 設定した供給量に基づいて、前記改質剤を前記基板に供給する工程と、を有する。